

日程表 (会場別) 1

青山学院大学

会場名	収容人数	3月27日(火)		3月28日(水)		3月29日(木)		3月30日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
F棟	A 2F-F201	81	9.6 接合、回路作製プロセスおよびデバイス応用	9.6 接合、回路作製プロセスおよびデバイス応用	9.3 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	7.1 X線技術	1.6 プラズマ現象一般		
	B 2F-F204	81	7.1 X線技術	2.3 計測標準	2.2 精密計測・ナノ計測	2.1 計測・制御技術	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉	「放射能のトレーサビリティとPETの定量化」
	C 3F-F301	81			11.2 半導体表面	11.2 半導体表面	1.4 プラズマ応用プロセス	1.4 プラズマ応用プロセス	1.3 反応性プラズマの診断と計測
	G 3F-F304	81	1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー	1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー	11.7 シミュレーション	11.7 シミュレーション	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源
	H 3F-F307	144	1.7 プラズマエッチング	1.7 プラズマエッチング		「光学設計・製作技術の最新トピックス—国際会議：ODF'06, Nara より—」	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換
	J 3F-F308	144	4.3 レーザー装置・材料	光・量子エレクトロニクス業績賞記念講演 4.3 レーザー装置・材料	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学
	K 3F-F306	81	3.3 機器・デバイス光学	3.3 機器・デバイス光学	11.1 基礎物性・評価	11.1 基礎物性・評価	14.1 基礎物性・評価	14.1 基礎物性・評価	15.5 エネルギー変換・貯蔵
	L 3F-F305	81	8.3 微粒子・粉体	8.6 新機能材料・新物性	9.2 新材料、新薄膜、新低温動作デバイス	9.4 臨界電流、超伝導パワー応用	9.1 基礎物性	9.1 基礎物性	9.1 基礎物性
	M 4F-F401	81	合同セッションG「量子情報の基礎と応用」	合同セッションD「プラズマ CVD の基礎と応用」	15.7 磁場応用	「リフレッシュ理科教室」開催して10年が経過—実施状況と抱える問題を考える—」		15.1 応用物理一般	15.1 応用物理一般
	N 4F-F404	81	13.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶	13.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶	13.6 IV 族系化合物	13.6 IV 族系化合物	13.6 IV 族系化合物		15.3 新技術 15.4 トライボロジー
	Q 4F-F407	144	8.2 誘電材料・誘電体	8.2 誘電材料・誘電体	13.7 エピタキシーの基礎	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶
	R 4F-F408	144	13.8 結晶評価、ナノ不純物・結晶欠陥	3.6 視覚・色彩 3.7 生体・医用光学	3.7 生体・医用光学	「分光センシング技術の新たな活用と展開」			
	S 4F-F406	81		3.4 計測光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学	8.4 ナノエレクトロニクス	8.4 ナノエレクトロニクス	3.2 材料光学
	T 4F-F405	81	13.1 バルク結晶成長	13.1 バルク結晶成長	13.1 バルク結晶成長	13.2 II-VI 族結晶	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造
E棟	V 1F-E101	385	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス	10.3 電子機能材料・デバイス	10.3 電子機能材料・デバイス	「エレクトロニクス有機界面幾何工学」	10.3 電子機能材料・デバイス
	W 1F-E102	303	10.9 特定テーマA：有機トランジスター	「多元化合物とナノテクノロジー」	10.9 特定テーマA：有機トランジスター	「日本学術振興会第161委員会企画「有機半導体薄膜結晶化の現状：エピタキシャル成長機構と結晶品質」	10.9 特定テーマA：有機トランジスター	「結晶工学分科会企画シンポジウム「シククロトン放射光の結晶工学への応用」	10.9 特定テーマA：有機トランジスター
	X 1F-E103	303	12.4 超高速・機能デバイス	12.4 超高速・機能デバイス	12.4 超高速・機能デバイス	12.4 超高速・機能デバイス	14 非晶質・微結晶分子内総合講演「Cat-CVD法の現状と今後の展開」	14 非晶質・微結晶分子内総合講演「Cat-CVD法の現状と今後の展開」	14.2 プロセス技術 14.3 デバイス
	Y 1F-E106	210	13.4 III-V 窒化物結晶			光学論文賞授賞式・受賞記念講演			
	ZA 1F-E105	210	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス
	ZB 1F-E104	210	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	
	ZC 2F-E201	357	13.6 IV 族系化合物	「目前に迫ったデバイス実用化を前に—SiCの完全結晶を求めて—」	13.4 III-V 窒化物結晶	「有機系原料におけるプラズマプロセス—低解離・低ダメージプロセスを目指して—」	「酸化亜鉛エレクトロニクスの進展と今後の展望」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」
	ZG 2F-E202	303	11.2 半導体表面	「半導体計測・評価技術—最先端プロセスからの要求と局所プロービング技術の可能性」	10.10 特定テーマB：生体分子計測・バイオナノテクノロジー	「SPMによる液相計測の新展開」	「日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会合同企画「Siバルク結晶系太陽電池のイノベーション」	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶
	ZH 2F-E203	303	11.3 絶縁膜技術	「SION から High-k 絶縁膜の信頼性科学—実用化に向けた最後の課題—」	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術
	ZJ 2F-E206	210		75周年記念特別シンポジウム「応用物理学会からの新たな挑戦—新たな協力関係の構築、新たな研究領域の開拓に向けて—」	12.5 半導体光物性・光デバイス	「公的研究費について考える—人材育成と国際競争力の観点から—」	6.2 カーボン系薄膜	特別企画シンポジウム「応用物理学の将来ビジョン」	
	ZK 2F-E205	210	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	「エネルギー・環境研究会設立記念シンポジウム「これからのエネルギー技術を考える」	11.3 絶縁膜技術

日程表 (会場別) 2

青山学院大学

会場名	収容人数	3月27日(火)		3月28日(水)		3月29日(木)		3月30日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
E棟	ZL 2F-E204	210	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	「テラヘルツ電磁波技術研究会企画「テラヘルツ波コンポーネント基礎と応用展望」」	11 半導体 A (シリコン) 分科内総合講演「LSI 多層配線に関するプロセス・信頼性メカニズムと最先端技術」	11 半導体 A (シリコン) 分科内総合講演「LSI 多層配線に関するプロセス・信頼性メカニズムと最先端技術」	13.4 III-V 窒化物結晶		
	ZM 3F-E301	385	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	「白色 LED の高性能化に向けた光物性研究最前線」	13.4 III-V 窒化物結晶
	ZN 3F-E302	303	合同セッション K「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッション K「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッション K「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッション K「酸化亜鉛系機能性材料」	業績賞記念講演 / 丸山瑛一氏 12.5 半導体光物性・光デバイス	13.4 III-V 窒化物結晶	12.5 半導体光物性・光デバイス
	ZQ 3F-E303	303	5.1 半導体レーザー・発光素子	業績賞記念講演 / 末松安壽氏 「次世代光ネットワーク実現に向けた光デバイス・コンポーネントの最近の進展」	11.6 Si デバイス / 集積化技術	「シリコンナノエレクトロニクスの新展開」特性はらつき解明とナノデバイスインテグリティ」	11.6 Si デバイス / 集積化技術	11.6 Si デバイス / 集積化技術	
	ZR 3F-E307	210	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」
	ZS 3F-E305	210	5.4 光制御	「超伝導分科会企画：「新展開：超伝導材料技術の革新とパワー・磁場応用最前線」」	光・電子集積技術 業績賞記念講演 5.4 光制御	「時代が求める分極反転光デバイス」	5.4 光制御	5.4 光制御	合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」
	ZT 3F-E304	210	合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	「さまざまな物質へのスピン注入と関連現象」	合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」
D棟	ZV 1F-D107	81	9.5 アナログ応用および関連技術	アナログ応用および関連技術	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	7.7 微小電子源	7.7 微小電子源	
	ZW 1F-D113	144	3.8 近接場光学	34.1 電磁メタマテリアル	14.1 基礎物性・評価	「ランダム系フォトエレクトロニクスのセルレンジビティ」	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス
	ZX 1F-D114	144	3.1 物理光学・光学基礎 3.9 光学新領域	「極高真空技術の科学と応用」	3.8 近接場光学	「ナノフォトニクスにおける物理現象を考える」	3.8 近接場光学	3.8 近接場光学	
	SA 2F-D211	81	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	7.8 ビーム応用一般・新技術	7.5 ビーム・光励起表面反応	
	SB 2F-D212	100	3.5 情報光学	「新画像システム研究会企画：「光・画像に基づく本人認証システムの展開」」	3.5 情報光学	3.5 情報光学	10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー
	SC 2F-D215	144	11.6 Si デバイス / 集積化技術	11.6 Si デバイス / 集積化技術	第 40 回スクール 「安全・安心に役立つ科学技術」		第 40 回スクール 「バイオテクノロジーの最前線と計測技術の進歩」		11.6 Si デバイス / 集積化技術
	SG 2F-D214	144	5.4 光制御	5.4 光制御	5.1 半導体レーザー・発光素子	5.1 半導体レーザー・発光素子	5.1 半導体レーザー・発光素子	5.2 光検出 5.3 光記録	5.4 光制御
	SH 3F-D307	100	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ	7.2 電子顕微鏡、評価、測定、分析
	SJ 3F-D313	100	10.6 高分子・ソフトマテリアル	10.6 高分子・ソフトマテリアル	4.1 量子光学・原子光学 4.6 レーザー分光応用・計測	4.6 レーザー分光応用・計測	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス
	SK 3F-D317	81	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.5 液晶	10.5 液晶	10.5 液晶
	SL 3F-D316	144	7.4 ナノインプリント	7.4 ナノインプリント	9.5 アナログ応用および関連技術	「超伝導検出器による電磁波-X線-生体分子分光計測技術の展望」	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡
	SM 3F-D315	144	12.3 プロセス技術・界面制御	12.3 プロセス技術・界面制御	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術
	SN 4F-D407	100			4.3 レーザー装置・材料	「プラズマフォトニクスの幕開けと展開」	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー
	SQ 4F-D413	100	「半導体プロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション」		6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料
	SR 4F-D416	144	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	「自己組織化膜の実用方向とその課題」		
SV 4F-D415	144	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	
アリーナ	ポスターセッション	6.5 表面物理・真空 8.1 磁性材料・磁気デバイス	[前半] 3.1 物理光学・光学基礎 3.9 光学新領域 10.9 特定テーマ A: 有機トランジスター		6.5 表面物理・真空 15.2 教育	[前半] 10.9 特定テーマ A: 有機トランジスター		[前半] 10.8 有機 EL	11.4 記録技術 12.1 探索的材料物性
			[後半] 7.1 X線技術 13.8 結晶評価、ナノ不純物・結晶欠陥			[後半] 7.1 X線技術 9.3 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長		[後半] 1.6 プラズマ現象一般 5.5 光ファイバー	